

## ■特 長

・4素子/1パッケージ

## ■用 途

- ・中速度スイッチング
- ・低周波増幅
- ・リレードライバ
- ・ソレノイドドライバ

■最大定格 〈 $T_a=25^\circ\text{C}$ 〉

| 項 目         | 記 号       | 定 格      | 単 位              |
|-------------|-----------|----------|------------------|
| コレクタ・ベース電圧  | $V_{CB0}$ | 50       | V                |
| エミッタ・ベース電圧  | $V_{EB0}$ | 5        | V                |
| コレクタ・エミッタ電圧 | $V_{CE0}$ | 30       | V                |
| コレクタ電流      | $I_C$     | 500      | mA               |
| コレクタ損失      | $P_C^*$   | 400      | mW               |
| 接合部温度       | $T_j$     | +150     | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度        | $T_{stg}$ | -55~+150 | $^\circ\text{C}$ |

\*1素子動作

■電気的特性 〈 $T_a=25^\circ\text{C}$ 〉

| 項 目           | 記 号           | 条 件                                                             | 規 格 |     |     | 単 位 |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|               |               |                                                                 | 最小値 | 標準値 | 最大値 |     |
| コレクタしゅ断電流     | $I_{CBO}$     | $V_{CB}=12\text{V}, I_E=0$                                      | —   | —   | 500 | nA  |
| エミッタしゅ断電流     | $I_{EBO}$     | $V_{EB}=2.5\text{V}, I_C=0$                                     | —   | —   | 500 | nA  |
| コレクタ・ベース降伏電圧  | $V_{(BR)CB0}$ | $I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$                                     | 50  | —   | —   | V   |
| エミッタ・ベース降伏電圧  | $V_{(BR)EB0}$ | $I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$                                     | 5   | —   | —   | V   |
| コレクタ・エミッタ降伏電圧 | $V_{(BR)CE0}$ | $I_C=10\text{mA}, R_{BE}=\infty$                                | 30  | —   | —   | V   |
| 直流電流増幅率       | $h_{FE}$      | $V_{CE}=2\text{V}, I_C=100\text{mA}$                            | 30  | —   | —   | —   |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | $V_{CE(sat)}$ | $I_C=200\text{mA}, I_E=10\text{mA}$                             | —   | 0.3 | 0.6 | V   |
| ベース・エミッタ飽和電圧  | $V_{BE(sat)}$ |                                                                 | —   | 0.9 | 1.2 | V   |
| コレクタ出力容量      | $C_{ob}$      | $V_{CB}=6\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$                        | —   | —   | 15  | pF  |
| スイッチング時間      | 上昇時間          | $I_C=120\text{mA}, I_{B1}=10\text{mA},$<br>$I_{B2}=-5\text{mA}$ | —   | —   | 80  | ns  |
|               | 蓄積時間          |                                                                 | —   | —   | 800 | ns  |
|               | 下降時間          | スイッチング時間測定回路参照                                                  | —   | —   | 150 | ns  |

## ■外形寸法図

